

膜状 SAPO-5 の合成

化学部 向吉郁朗, 清住嘉道*, 佐野庸治*, 水上富士夫*

Synthesis of Molecular Sieve SAPO-5 Film

Ikuro MUKOYOSHI, Yoshimiti KIYOZUMI*, Taneji SANO* and Fujio MIZUKAMI*

SiO_2 源, Al_2O_3 源および結晶化時間をかえて SAPO-5 膜を合成した。得られた膜の両面と粉末の形態観察と組成分析から、結晶化の初期においては、アルミノリン酸塩 ($\text{AlPO}-5$) が優先的に合成されていること、および SAPO-5 結晶内の Si 分布は、用いた原料に大きく依存することが明らかになった。

1. はじめに

筆者らは、シリコアルミノリン酸塩 (SAPO) の結晶化過程の解明という観点から、SAPO 結晶だけからなる膜の合成を検討しており、SAPO-5 を含むいくつかの SAPO 膜が得られることを見い出した。

ここでは SAPO-5 の結晶化過程についてさらに詳しく調べるために SiO_2 源の影響と結晶化時間の影響について検討を行い、合成した SAPO-5 膜の両面の形態観察及び組成分析を行った結果について報告する。

2. 実験

2.1 試薬

SiO_2 源としてコロイダルシリカ (カタロイド SI-30 触媒化成線; 30.4 wt % SiO_2 , 0.38 wt % NaO_2 , 水分 69.22 wt %) 及びケイ酸エチルを用いた。

Al_2O_3 源としてアルミニウムイソプロポキシド, P_2O_5 源として 85% リン酸、結晶化調整剤としてジエチルエタノールアミン (DEA) を用いた。

2.2 合成法

図 1 に示す手順で SiO_2 源, Al_2O_3 源, P_2O_5 源、結晶化調整剤および蒸留水を 1.0 Al_2O_3 : 1.0 P_2O_5 :

0.3 SiO_2 : 1.0 DEA : 47 H_2O のモル比になるように混合調製した水性ゲル混合物を、図 2 に示すテフロン製内筒を有する内容積 50 ml のステンレス製オートクレーブを用い、テフロン板存在下 200°C で 1 ~ 120 時間の範囲で水熱合成することにより SAPO-5 の粉末が容器の底に SAPO-5 の膜がテフロン板上に生成する。

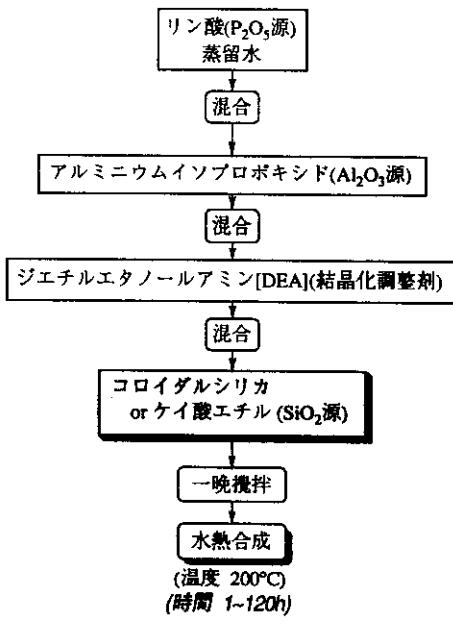


図 1 SAPO-5 の合成手順

* 工業技術院化学技術研究所

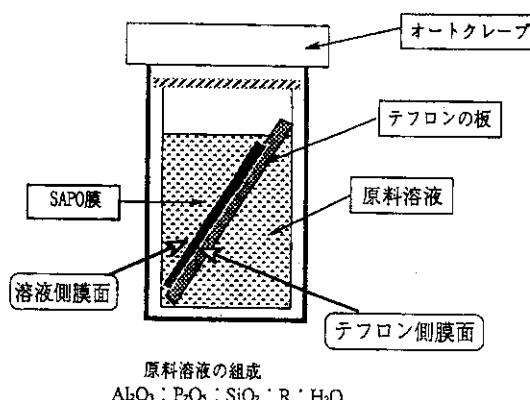


図2 SAPO-5結晶膜の合成法

2.3 SAPO-5のキャラクタリゼーション 生成物の同定はX線回折を用いた。

成分分析はAl, P, Siの三成分について行い、バルクの分析にはICPを用い、表面の分析と結晶の形態観察にはEDXつき走査形電子顕微鏡を用いて分析を行った。

そのほか、 $^{29}\text{Si-NMR}$ 、比表面積についても測定した。

3. 結果及び考察

写真1に300mℓのオートクレーブを用いて合成したSAPO-5膜を示す。



写真1 合成したSAPO-5膜

ここでSAPO膜は図2のようにテフロンの板の上に形成されテフロン側から溶液側へ成長するためにテフロン側は結晶化初期の結晶を溶液側は後で形成された結晶を反映している。

図3にコロイダルシリカを用いた場合のSAPO-5の膜の両面及び粉末のX線回折パターンを示す。

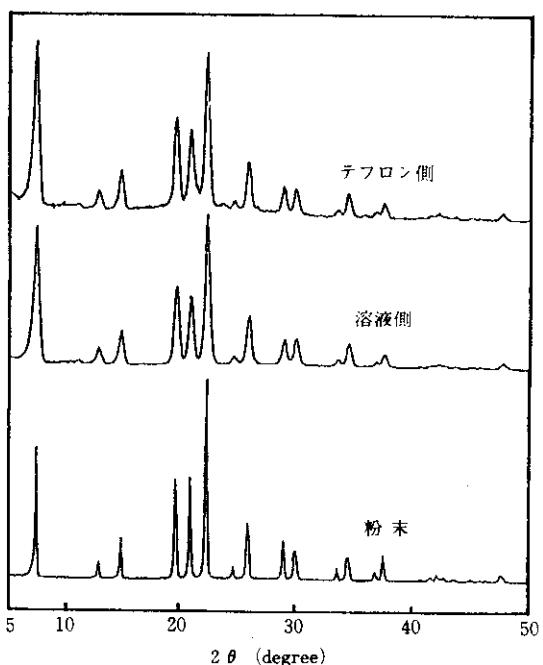


図3 X線回折パターン

SiO₂源：コロイダルシリカ

3つともSAPO-5のX線回折パターンを示しており、膜及び粉末ともほぼ均一な結晶構造を持つ事がわかる。

ケイ酸エチルを用いた場合も同様の結果が得られた。

つぎに、走査型電子顕微鏡により膜の両面と断面の結晶形態の観察を行った。写真2～7に電子顕微鏡写真を示す。写真より合成されたSAPO-5膜は小さな結晶からなる多結晶膜であることがわかる。

また、コロイダルシリカを用いた場合では膜の両面で結晶の大きさが異なりテフロン側は小さな

写真2 溶液側 (SiO₂源：コロイダルシリカ)写真5 溶液側 (SiO₂源：ケイ酸エチル)写真3 テフロン側 (SiO₂源：コロイダルシリカ)写真6 テフロン側 (SiO₂源：ケイ酸エチル)写真4 膜の断面 (SiO₂源：コロイダルシリカ)写真7 膜の断面 (SiO₂源：ケイ酸エチル)

表1 SAPO-5 合成条件とキャラクタリゼーション

合成条件 SiO ₂ 源 時間 (h)	膜						粉末			
	膜厚 (μm)	表面		バルク		結晶化度 (%)	表面		バルク	
		P/Al	Si/Al	P/Al	Si/Al		P/Al	Si/Al	P/Al	Si/Al
CS 1						0				
CS 2						12				
CS 3	60~100	1.18	0.033	1.13	0.085	58	1.03	0.067		
CS 24	70~120	385	1.12	0.055	1.08	0.122	0.962	0.0524	91	1.07 0.177 0.905 0.0735
CS 72	90~130	350	1.13	0.085	1.07	0.172			94	1.08 0.179
CS 120	160~280	388	1.12	0.081	1.03	0.193			100	345 1.07 0.164
TEOS 3						57				
TEOS 24	100~180	1.19	0.139	1.10	0.155	98				
TEOS 72	190~230	397	1.28	0.139	1.19	0.167	0.876	0.156	100	393
non 24	130~150	326	1.18		1.19	1.03			1.17	1.01

a Determined by EDX.

d Relative crystallinity.

b Determined by ICP.

CS : Colloidal silica.

c Determined by N₂ adsorption at -196°C.

TEOS : Tetraethyl orthosilicate.

結晶の集まりで、溶液側では大きな結晶の集まりで構成されていることがわかった。一方、ケイ酸エチルを用いた場合、どちらの面においても結晶の大きさにほとんど差がみられなかった。

表1に、生成条件とキャラクタリゼーションの結果を示す。

得られた膜の厚さは一様ではなかったが、結晶化時間とともに増大し、結晶化時間120時間後では150~300 μmであった。比表面積は300~400 m²/gであり結晶化時間との相関は特にみられなかった。

つぎにSi/Al比について、用いたSiO₂源がコロイダルシリカの場合のSi/Al比と結晶化時間の関係を図4に示す。

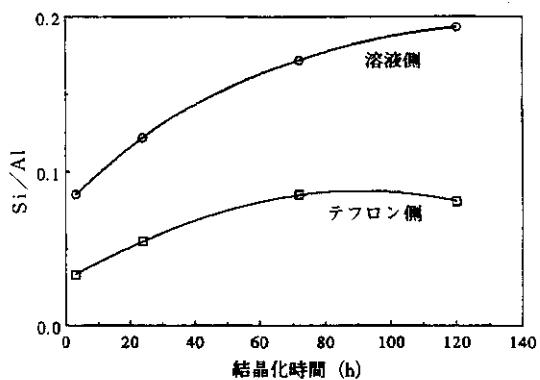


図4 結晶化時間とSi/Alの関係

SiO₂源：コロイダルシリカ

これから、膜の両面において Si/Al 比が結晶化時間とともに大きくなっていくことがわかった。また、同じ結晶化時間で膜の両面を比較するとテフロン側よりも溶液側の方が大きいことがわかった。

用いた SiO_2 源がケイ酸エチルの場合、テフロン側と溶液側の Si/Al 比の差は小さかった。

のことから、コロイダルシリカを用いた場合、結晶化初期においては SiO_2 がとりこまれにくく、 $\text{AlPO}-5$ が優先的に合成されていることがわかる。

また、原料によって結晶化初期における SiO_2 のとりこまれ方に違いがあることもわかった。

次に Si が結晶骨格構造中にあるかどうかを見るために ^{29}Si の NMR を測定した。図 5 に NMR のパターンを示す。

アルミが 4 配位している Si のピークがみられることがから Si が結晶骨格構造中にあることがわかる。

NMR のパターンは原料に関係なく大体 2 つのパターンにわかれ、Si/Al 比が低い場合、(A) の様にアルミが 4 配位している Si のピークだけがみられる。また、Si/Al 比が高い場合、(B) の様に、結晶骨格構造外の Si のピークもみられるようになる。

4. おわりに

今回の研究で、つぎのことが明らかになった。

- ① 結晶化時間とともに Si が結晶に取り込まれる割合が増加する。
- ② 結晶化初期に結晶に取り込まれる Si の割合は用いる原料に大きく依存する。

重合度の高いコロイダルシリカを用いた場合、結晶化初期に結晶構造中に Si が取り込まれにくく、モノメリックなケイ酸エチルを用いた場合、結晶化初期から Si が取り込まれやすい。

- ③ NMR の結果から原料に関係なく Si/Al 比が大きくなると SAPO-5 結晶骨格構造外の Si が増加する。

参考文献

- 1) ブレント・メイ・タク・ロウ、セレステ・アンネ・メシーナ、ロバート・ライル・パットン、リチャード・タデウス・ガジエク、特開 昭59-35018号 (1984)
- 2) B.M.Lok, C.A.Messina, R.L.Patten, R.T. Gajek, T.R.Cannan and E.M.Flanigen, J. Am.Chem.Soc., 106, 6092 (1984)
- 3) J.M.Bennett and W.J.Dytrych, J.J.Pluth, J.W.Richardson, Jr and J.V.Smith, ZEOLITES, 6, September, 349 (1986)
- 4) 新重光、ニューセラミックス, 3, 85 (1989)
- 5) 新重光、ニューセラミックス, 4, 69 (1989)

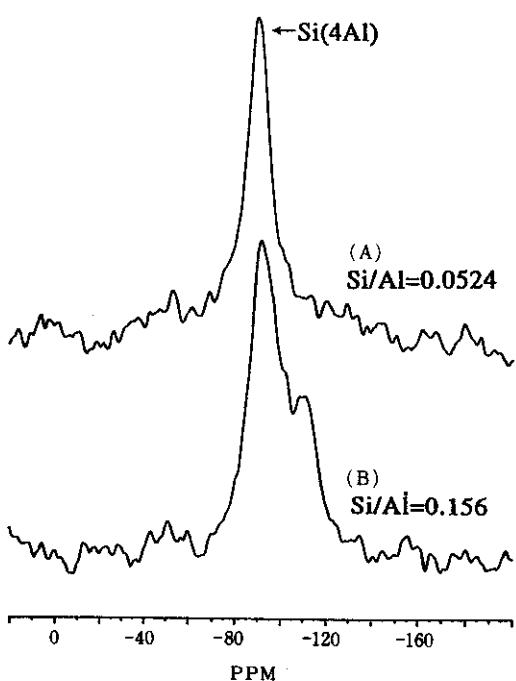


図 5 ^{29}Si -MAS-NMR スペクトル